LIGHT ABSORBING ANTIREFLECTION BODY

Patent number:

JP2002071902

Publication date:

2002-03-12

Inventor:

YAMADA TOMOHIRO; TAKAGI SATORU

Applicant:

ASAHI GLASS CO LTD

Classification:

- international:

G02B1/11; B32B7/02; B32B9/00; B32B15/04;

H01J29/88; G02B1/10; B32B7/02; B32B9/00;

B32B15/04; H01J29/88; (IPC1-7): G02B1/11; B32B7/02;

B32B9/00; B32B15/04; H01J29/88

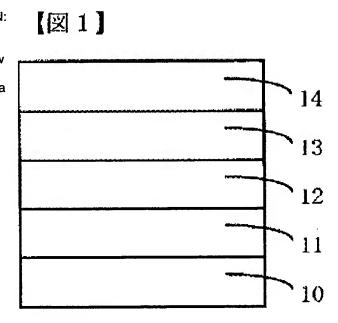
- european:

Application number: JP20000256060 20000825 Priority number(s): JP20000256060 20000825

Report a data error here

Abstract of JP2002071902

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light absorbing antireflection body having a low surface resistance, low reflecting performance, heat resistance and a nearly constant transmittance in the visible region. SOLUTION: A first light absorbing film 11, a high refractive index film 12 having a refractive index of 1.9-2.7, a second light absorbing film 13 and a low refractive index film 14 having a refractive index of 1.35-1.6 are successively formed on a substrate 10 to obtain the objective light absorbing antireflection body. The first light absorbing film 11 is a metallic film comprising an alloy of one or more metals selected from the group consisting of Ti, Zr and Hf and one or more elements selected from the group consisting of Si and Al. The second light absorbing film 13 is a metallic film containing one or more metals selected from the group consisting of Ti, Zr and Hf or a nitride film.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

1 family member for: JP2002071902 Derived from 1 application

LIGHT ABSORBING ANTIREFLECTION BODY

Inventor: YAMADA TOMOHIRO; TAKAGI SATORU Applicant: ASAHI GLASS CO LTD

IPC: G02B1/11; B32B7/02; B32B9/00 (+12)

Publication info: JP2002071902 A - 2002-03-12

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-71902

(P2002-71902A) (43)公開日 平成14年3月12日(2002.3.12)

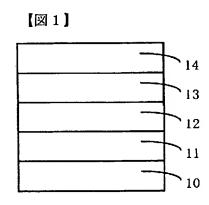
(51) Int. Cl. '	識別記号	FΙ		テーマコード(参考	
G02B 1/11		B32B 7/02	103	2K009	
B32B 7/02	103	9/00	A	4F100	
9/00		15/04	В	5C032	
15/04		H01J 29/88			
H01J 29/88		G02B 1/10	A		
		審査請求	未請求 請求項の数8	OL (全12頁)	
(21)出願番号	特願2000-256060(P2000-256060)	(71)出願人	000000044 旭硝子株式会社		
(22)出顧日	平成12年8月25日(2000.8.25)		東京都千代田区有楽町-	一丁目12番1号	
(52) [23]	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者	山田 朋広		
			神奈川県横浜市神奈川 旭硝子株式会社内	区羽沢町1150番地	
		(72)発明者	高木 悟		
			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社内		
			7E-13 7 F1-24 (21)		

(54) 【発明の名称】光吸収性反射防止体

(57)【要約】

【課題】低い表面抵抗値、低反射性能、耐熱性を有し、 可視域において透過率がほぼ一定な光吸収性反射防止体 の提供。

【解決手段】基体10側から順に、第1の光吸収膜11、屈折率が1.9~2.7の高屈折率膜12、第2の光吸収膜13、屈折率が1.35~1.6の低屈折率膜14が形成されてなり、第1の光吸収膜11が、Ti、乙rおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属とSiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素との合金からなる金属膜であり、第2の光吸収膜13が、Ti、乙rおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属を含む金属膜または窒化物膜である光吸収性反射防止体。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基体上に、基体側から順に、膜厚が1~30nmの第1の光吸収膜、膜厚が20~100nmの高屈折率膜、膜厚が1~30nmの第2の光吸収膜、膜厚が50~150nmの低屈折率膜が形成されてなる光吸収性反射防止体であって、

第1の光吸収膜が、Ti、Zr およびHf からなる群から選ばれる1種以上の金属とSi およびAl からなる群から選ばれる1種以上の元素との合金からなる合金膜であり、

高屈折率膜が波長400~700nmにおいて1.9~ 2.7の屈折率を有する膜であり、

第2の光吸収膜が、前記高屈折率膜とは異なる組成からなり、かつ該第2の光吸収膜が、Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属からなる金属膜、該金属の窒化物膜、Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属とSiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素との合金からなる合金膜、または、該合金の窒化物膜であり、

低屈折率膜が波長400~700nmにおいて1.35 20~1.6の屈折率を有する膜である光吸収性反射防止 体。

【請求項2】高屈折率膜が、SiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素の窒化物膜、該元素の酸窒化物膜、または、Sn、Zn、Zr、In、Ta、Nb、Ti、BiおよびCrからなる群から選ばれる1種以上の金属の酸化物膜である請求項1に記載の光吸収性反射防止体。

【請求項3】低屈折率膜が、Siの酸化物膜またはMg のフッ化物膜である請求項1または2に記載の光吸収性 30 反射防止体。

【請求項4】低屈折率膜側からの入射光に対する膜面の みの可視光反射率が0.6%以下である請求項1、2ま たは3に記載の光吸収性反射防止体。

【請求項5】基体がガラス基体である請求項1~4のいずれかに記載の光吸収性反射防止体。

【請求項6】可視光透過率が35~90%である請求項1~5のいずれかに記載の光吸収性反射防止体。

【請求項7】前記4層の膜が形成された側とは反対側からの入射光に対する可視光反射率が10%以下である請 40 求項1~6のいずれかに記載の光吸収性反射防止体。

【請求項8】基体と第1の光吸収膜との間に、Siの窒化物膜および/またはSiの炭化物膜が形成されてなる請求項1~7のいずれかに記載の光吸収性反射防止体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光吸収性反射防止 体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータの急速な普及ととも 50 に、膜厚(幾何学的膜厚の意であり、以下も同様。)が

に、端末オペレータの作業環境を改善するために、ディスプレイ表面の反射低減や帯電防止が要求されつつある。特にCRT(陰極線管)では、コントラスト向上のためにCRTパネルガラスの透過率を低下させたり、電磁波を遮蔽することが求められるようになってきている。

【0003】一方、近年、CRTディスプレイの平面化が進み、CRTパネルガラスの中央部と周辺部に、従来の曲面管に比べて大きな肉厚差が強度上必須となるため、従来のように、透過率の低いガラス素地を用いてコントラストを向上させる手段では、画面中央部と画面周辺部の明るさが異なる欠点が生ずるようになってきた。【0004】そこで、CRTパネルガラスに、より透過率の高いガラス素地を用いることが提案されている。その一方で、高透過率のガラス素地を用いた場合にはコントラストの低下をまねく。そこで、CRT表面に形成する反射防止膜として、透過率を低くしたものが要求されている。

【0005】従来技術として、基体側から順に、遷移金属窒化物膜/透明膜/遷移金属窒化物膜/透明膜の4層の多層膜からなる低透過率の反射防止膜が提案されている(米国特許第5,091,244号)。しかし、この反射防止膜では、波長650nm付近の透過率が波長550nm付近の透過率に比べてかなり低下する。結果、CRTの赤色の輝度を上げるためにカソード電流の増加が必要になるが、その場合、電子ビームのスポット精度が悪化する(スポット精度の悪化は、特に赤色に用いられる電子ビームで顕著)ため、高解像度化が難しいという問題があった。

[0006] また別の従来技術として、基体側から順に、Cr膜/Siの窒化物膜/Tiの窒化物膜/Siの酸化物膜の4層の多層膜からなる低透過率の反射防止膜が提案されている(特開2000-193801)。一方、反射防止膜は、熱処理に耐えられることが望まれている。例えば、CRTパネルガラスの表面に反射防止膜を成膜した後、該CRTパネルガラスにはCRTとして製品化される工程において、大気雰囲気で約450℃の熱処理が施される。前記の特開2000-193801記載の反射防止膜では、前記熱処理前後で可視光反射率が変化し、実用上、耐熱性は必ずしも充分ではない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、電磁波遮蔽性能を発現しうる低い表面抵抗値を有するとともに、膜面側からの入射光に対して低反射性能を有し、かつ400~700nmの波長域の全域において透過率がほぼ一定であって、耐熱性に優れた光吸収性反射防止体の提供を目的とする。

[0008]

4 はればり りついてったさ

1~30nmの第1の光吸収膜、膜厚が20~100n mの高屈折率膜、膜厚が1~30nmの第2の光吸収 膜、膜厚が50~150nmの低屈折率膜が形成されて なる光吸収性反射防止体であって、第1の光吸収膜が、 Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上 の金属とSiおよびAlからなる群から選ばれる1種以 上の元素との合金からなる合金膜であり、高屈折率膜が 波長400~700nmにおいて1.9~2.7の屈折 率を有する膜であり、第2の光吸収膜が、前記高屈折率 膜とは異なる組成からなり、かつ該第2の光吸収膜が、 Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上 の金属からなる金属膜、該金属の窒化物膜、Ti、Zr およびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属とS i およびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素と の合金からなる合金膜、または、該合金の窒化物膜であ り、低屈折率膜が波長400~700nmにおいて1. 35~1.6の屈折率を有する膜である光吸収性反射防 止体である。

【0009】本発明における第1の光吸収膜は、Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属 20 (A群)とSiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素 (B群)との合金からなる金属膜である。特に、光学特性および生産性の観点から、A群の金属としてはTiであることが好ましい。第1の光吸収膜として具体的には、TiSi合金膜、TiAl合金膜が挙げられる。

【0010】なお、TiSi合金膜の場合には、反射防止能の観点から、Si/(Ti+Si)の原子比が0超0.7未満であることが好ましい。本発明における第1の光吸収膜の好ましい膜厚は $1\sim25$ nmである。

【0011】本発明における第2の光吸収膜は、A)Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属からなる金属膜、B)該金属の窒化物膜、C)Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属とSiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素との合金からなる合金膜、または、D)該合金の窒化物膜、である。耐久性や生産性の観点から、第2の光吸収膜は、B)の膜、特にTiの窒化物膜であることが好ましい。Tiの窒化物を含む膜の代表例であるTiの窒化物膜は、後述する低屈折率膜として好適なSiの酸化物膜と組合わせて用いられることにより、低屈折率膜側からの入射光に対する低反射性能発現に有利な光学定数をとる。本発明における第2の光吸収膜の好ましい膜厚は1~25nmである。

【0012】本発明における高屈折率膜は、Siおよび A1からなる群から選ばれる1種以上の元素の窒化物膜、該元素の酸窒化物膜、または、Sn、Zn、Zr、In、Ta、Nb、Ti、Bi およびCr からなる群から選ばれる1種以上の金属の酸化物膜であることが好ましい。特に、 $400\sim700$ nm(以下、可視域とい

う)の全域における消衰係数が 0.03以下である透明 高屈折率膜であることが好ましい。

【0013】前記の透明高屈折率膜としては、Si3よびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素の窒化物膜や、Sn、Zn、Zr、In、Ta、NbおよびTiからなる群から選ばれる1種以上の金属の酸化物膜が挙げられる。特に、屈折率、耐久性の観点から、Siの窒化物膜であることが好ましい。

[0014] 高屈折率膜としては、微吸収性高屈折率膜 10 も用い得る。より低い透過率を発現させるうえでは微吸収性高屈折率膜を用いることが好ましい。微吸収性高屈折率膜は、可視域における消衰係数が0.05~0.6 (特に0.05~0.4)の範囲にあり、かつその消衰係数が短波長側ほど大きい材料からなることが好ましい

【0015】前記の微吸収性高屈折率膜としては、Siの窒化物膜、Siの酸窒化物膜、Biの酸化物膜またはCrの酸化物膜が挙げられる。特に、屈折率、耐久性の観点から、Siの窒化物膜(例えば酸素をわずかに含有するSiの窒化物膜)であることが好ましい。本発明における高屈折率膜の好ましい膜厚は30~100nmである。

【0016】本発明における低屈折率膜は、可視域全域における消衰係数が0.03以下である透明低屈折率膜であることが好ましい。前記透明低屈折率膜としては、Siの酸化物膜またはMgのフッ化物膜が挙げられる。特に、屈折率、耐久性の観点から、Siの酸化物膜であることが好ましい。本発明における低屈折率膜の好ましい膜厚は60~130nmである。

30 【0017】本発明における各種の膜の成膜方法は特に限定されず、スパッタリング法、CVD法、スピンコート法、ディップコート法などが挙げられる。生産性の観点からは、いずれの膜もスパッタリング法で成膜されることが好ましい。

[0018] 第1の光吸収膜については、例えば、Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属とSiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素との合金からなるターゲットを不活性ガス雰囲気中でスパッタリングする。成膜された第1の光吸収膜には少量の不純物が含まれてもよい。高屈折率膜であるSiの窒化物膜については、例えば、導電性のSiターゲットを窒素ガスの存在下でスパッタリングする。ターゲットに導電性を持たせるために少量の不純物が添加され得るが、成膜されたSiの窒化物膜中に該不純物が含まれてもよい。また、Siの窒化物膜には微量の酸素が含まれてもよい。

【0019】第2の光吸収膜である前記A)の膜については、例えば、Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属からなるターゲットを不活性ガス50 雰囲気中でスパッタリングする。第2の光吸収膜である

前記B)の膜については、例えば、Ti、ZrおよびH f からなる群から選ばれる 1 種以上の金属からなるターゲットを窒素ガスの存在下でスパッタリングする。

【0020】第2の光吸収膜である前記C)の膜については、例えば、Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属とSiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素との合金からなるターゲットを不活性ガス雰囲気中でスパッタリングする。第2の光吸収膜である前記D)の膜については、例えば、Ti、ZrおよびHfからなる群から選ばれる1種以上の金属と10SiおよびAlからなる群から選ばれる1種以上の元素との合金からなるターゲットを窒素ガスの存在下でDCスパッタリングする。成膜された第2の光吸収膜には少量の不純物が含まれてもよい。

【0021】低屈折率膜であるSiの酸化物膜については、例えば、導電性のSiターゲットを酸素ガスの存在下でスパッタリングする。ターゲットに導電性を持たせるために少量の不純物が添加され得るが、成膜されたSiの酸化物膜中に該不純物が含まれてもよい。

【0022】本発明の光吸収性反射防止体は、視認性向 20 上の観点から、低屈折率膜側からの入射光に対する膜面 のみの可視光反射率(以下、膜面可視光反射率という) が0.6%以下であることが好ましい。膜面可視光反射 率は、基体の裏面(膜が形成された面とは反対側の面) に黒色ラッカーを塗布して裏面反射を消して、膜面のみ の可視光反射率として測定される。

【0023】本発明において用いられる基体は特に限定されず、ガラス基体、プラスチック基体などの透明基体が挙げられる。ガラス基体としては、CRTを構成するパネルガラス、熱封着後のCRT(パネル表面に成膜さ 30れる)、ディスプレイ(例えばCRTやPDP等)と操作者との間に設置されるフィルタを構成するガラス基板などが挙げられる。

【0024】プラスチック基体としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)からなるプラスチック基板やプラスチックフィルムなどが挙げられる。プラスチックフィルムはディスプレイ等の表面に貼付して用いられる。基体としてプラスチック基体を用いた場合は、本発明の耐熱性改善の効果を利用できないが、基体としてガラス基体(特にCRT用パネルガラス)を用いた場合は、本発明の耐熱性改善の効果が顕著にあらわれる。

【0025】光吸収性反射防止体は、コントラスト向上 およびディスプレイの輝度の観点から、可視光透過率が 35~90%(特に35~70%)であることが好まし い。光吸収性反射防止体は、二重像(ディスプレイに映 る像が二重に見えること)を軽減する観点から、本発明 における4層の膜が形成された側とは反対側からの入射 光に対する可視光反射率が10%以下であることが好ま しい。

【0026】熱処理(大気雰囲気、450℃)前後での 50

透過率変化を効果的に抑えられることから、基体と第1の光吸収膜との間に、Siの窒化物膜および/またはSiの炭化物膜が形成されることが好ましい。膜厚は $1\sim10$ nm、特に $2\sim7$ nmであることが好ましい。低反射性の観点からは、Siの炭化物膜であることが好ましい。

[0027]

【実施例】 [例1 (実施例)] 真空槽内に、Ti-15 a t % Si 合金と、多結晶 Si (Bドープ) と、金属Ti とをそれぞれターゲットとしてカソード上に設置し、真空槽を 5×10 「Pa まで排気した。真空槽内に設置したソーダライムガラス基板 10 上に、次のようにして図1に示す4層膜を形成した。なお、Ti-15 a t % Si 合金とは、Ti とSi の総量に対してSi が 15 原子%合有された合金の意であり、以下も同様とする。【0028】 (1) まず放電ガスとしてアルゴンを導入し、圧力が 3×10^{-1} Pa になるようコンダクタンスを調整した。次いでTi-15 a t % Si のカソードに 1.4 W/c m^i の電力密度で直流を投入し、直流 (DC) スパッタリングにより 5n mのTi Si . 膜 11 を成膜した。

(2) ガス導入を停止し、真空槽内を高真空とした後、放電ガスとしてアルゴンと窒素の混合ガス(Ar/N, =1/1)を導入し、圧力が 3×10^{-1} Paになるようコンダクタンスを調整した。次いでSi のカソードに2. $8W/cm^{1}$ の電力密度で直流を投入し、DCスパッタリングにより60nmの透明なSiN, 膜12を形成した。

【0029】 (3) ガス導入を停止し、真空槽内を高真空とした後、放電ガスとしてアルゴンと窒素の混合ガス ($Ar/N_1 = 4/1$) を導入し、圧力が 3×10^{-1} Paになるようコンダクタンスを調整した。次いでTiOカソードに1.9 W/cm^2 の電力密度で直流を投入し、DCスパッタリングにより10 $nmOTiN_1$ 膜13を成膜した。

 (4) ガス導入を停止し、真空槽内を高真空とした後、 放電ガスとしてアルゴンと酸素の混合ガス(Ar/O₁ = 1/2)を導入し、圧力が3×10⁻¹ Paになるよう コンダクタンスを調整した。次いでSiのカソードに
5. 6 W/c m¹ の電力密度で直流を投入し、DCスパッタリングにより100nmの透明なSiO₁ 膜14を 形成した。

【0030】得られた光吸収性反射防止体について、分光透過率を測定した。また、このサンプルの膜面可視光反射率を求めるために膜が形成された側の分光反射率(以下膜面分光反射率という)を測定した。膜面分光反射率はガラス基板の裏面(膜が形成された面とは反対側の面)に黒色ラッカーを塗布して裏面反射を消した状態で測定した。また、ガラス基板の裏面側の分光反射率(以下ガラス面側分光反射率という)も測定した。得ら

れた分光透過率の曲線15、ガラス面側分光反射率の曲 線16および膜面分光反射率の曲線17を図2に示し た。

[0031] [例2~5 (実施例)、例6~7 (比較 例)]例1における一部の条件を表1、2に示すように 変更した以外は例1と同様にして、各種の光吸収性反射 防止体を作製した。ただし、表1には示していないが、 例5では基板10と膜11との間にSiN.膜を5nm 形成した。例1~7の膜構成を表3に示す。例2~7で 面側分光反射率曲線および膜面分光反射率曲線を、それ ぞれ図4、図6、図8、図10、図12、図14に示し た。

【0032】例1~7の光吸収性反射防止膜付きガラス を約5 c m角に切り出し、シート抵抗値を非接触式の導 電率計で測定した。シート抵抗値は電磁波遮蔽の観点か ら、1 k Ω/□以下、特に500Ω/□以下であること が好ましい。シート抵抗値、分光曲線から求めた膜面可 視光反射率(膜面のみ)、可視光透過率(ガラス基板込

み) およびガラス面側可視光反射率(ガラス基板込み) を表4に示す。なお、可視光透過率およびガラス面側可 視光反射率はJIS R3106に基づいて測定した。 【0033】また、例1~6の光吸収性反射防止膜付き ガラスにそれぞれ大気雰囲気中、450℃、30分の熱 処理を2回施した。例1~6の熱処理後の光吸収性反射 防止体の分光透過率曲線、ガラス面側分光反射率曲線お よび膜面分光反射率曲線を、それぞれ図3、図5、図 7、図9、図11、図13に示した。該熱処理後の、シ 得られた光吸収性反射防止体の分光透過率曲線、ガラス 10 一ト抵抗値、分光曲線から求めた膜面可視光反射率(膜 面のみ)、可視光透過率(ガラス基板込み)およびガラ ス面側可視光反射率(ガラス基板込み)も表4に示す。 【0034】本発明の光吸収性反射防止体(例1~5) は、650mm付近の透過率が550mm付近の透過率 に比べて大きく低下することがなく、熱処理後も膜面可 視光反射率の絶対値の増加は0.2%以下に抑えられて

> [0035]【表1】

	例1	9 12	例3	914	
膜11					
ターゲット	ターゲット Ti-15at%Si		Ti-15at%Al	Ti-65at%Si	
ガス	ガス Arのみ		Ar のみ	Arのみ	
膜厚	5nm_	6nm	5nm	8nm	
膜12					
ターゲット	ターゲット Si		Si	Si	
ガス Ar/N ₂ =1/1		Ar/N ₂ =1/1	Ar/N ₂ =1/1	Ar/N ₂ =1/1	
膜厚 60nm		70nm	60nm	70nm	
膜13					
ターゲット Ti		Ti	Ti	Ti-65at%Si	
ガス Ar/N ₂ =4/1		Ar/N ₂ =4/1 Ar/N ₂ =4/1		Arのみ	
膜厚 10nm		8nm	10nm	6nm	
膜14					
ターゲット	Si	Si	Si	Si	
ガス	Ar/O ₂ =1/2	Ar/O ₂ =1/2	Ar/O ₂ =1/2	Ar/O ₂ =1/2	
膜厚	100nm	80nm	100nm	80nm	

[0036] 【表2】

		9	
	例 5	例6	例7
膜11			
ターゲット	Ti-15at%Si	Ti	Si
ガス	ガス Arのみ		Ar のみ
膜厚	5nm	15nm	9nm
膜12			
ターゲット	Si	Si	Si
ガス	Ar/N ₂ =1/1	Ar/N ₂ =1/1	Ar/N ₂ =1/1
膜厚	60nm	40nm	100nm
膜13			
ターゲット	Ti	Ti	Tì
ガス	ガス Ar/N ₂ =4/1		Ar/N ₂ =4/1
膜厚	膜厚 10nm		10nm
膜14			
ターゲット	Si	Si	Si
ガス	Ar/O ₂ =1/2	Ar/O ₂ =1/2	Ar/O ₂ =1/2

86nm

90nm

[0037] 【表3】

例	
1	ガラス/TiSix/SiNx/TiNx/SiO2
2	ガラス/TiSix/SiNx/TiNx/SiO2
3	ガラス/TiAl _x /SiN _x /TiN _x /SiO ₂
4	ガラス/TiSix/SiNx/TiSix/SiO2
5	#5x/SiNx/TiSix/SiNx/TiNx/SiO2
6	ガラス/TiN _x /SiN _x /TiN _x /SiO ₂
7	ガラス/Si/SiN _x /TiN _x /SiO ₂

[0038]

膜厚

100nm

【表4】

	熱処理前			熱処理後				
例	可視光透過 率(%)	膜面可視光反	ガラス面側可	シート抵抗 値(Ω/□)	可視光透過率(%)	膜面可視光反	ガラス面側可 視光反射率(%)	シート抵抗 値(Ω/□)
1	47.0	0. 2	9. 1	250	54.6	0. 2	8. 0	303
2	50.2	0.1	9.5	166	55.0	0.3	7.7	185
3	43.5	0.1	9.5	250	48.5	0.1	9. 1	303
4	31.9	0.4	11.6	294	40.9	0.1	10.0	312
5	46.4	0.1	9.0	250	48.8	0.1	9.8	263
6	44.2	0.1	10. 2	128	50.5	0.3	9.1	243
7	55.7	1.1	15.9	357		熱処	理せず	

[0039]

【発明の効果】本発明によれば、簡単な膜構成で総膜厚 をあまり大きくすることなく、適度な光吸収率を有し、 膜面側からの入射光に対して低反射性能を有する光吸収 性反射防止体を得ることができる。また、本発明の光吸 収性反射防止体は、特定の光吸収膜を2層有するのでシ ート抵抗値が低く、実用上充分な電磁波遮蔽性能を発現

【0040】本発明の光吸収性反射防止体を、ディスプ レイの表示面を構成するガラス(例えばCRT用パネル 40 ラス、フィルタガラス等として用いれば、表示画面のコ ントラストを改善でき、その効果は透明反射防止体を用 いた場合より顕著となる。また、本発明の光吸収性反射 防止体は、裏面からの入射光に対しても反射率が低く、 いわゆる二重像の程度が軽減される。したがって、フラ ットな表面形状を有するCRTに本発明の光吸収性反射 防止体を用いれば、中央部と周辺部での輝度差がなく、 また二重像による視認性の低下もないCRTが得られ

【0041】また、本発明の光吸収性反射防止体は、可 ガラスやPDP用の前面ガラス)、フェイスプレートガ 50 視域にわたってほぼ一定な透過特性を有するため、電子

ピームのスポット精度が悪化するほどにはカソード電流を増す必要がなく、高解像度化に有利である。また、耐熱性に優れるため、CRT製造における真空熱封着工程に要求される程度の熱処理には充分耐えられる。したがって、CRT用パネルガラスに本発明の光吸収性反射防止体を用いれば、成膜した後に熱処理し、CRTを組み立てることができる。また、CRTに限らず、耐熱性の要求される用途への適用が期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一例を示す模式的断面図。

【図2】例1の分光透過率、ガラス面側分光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図3】例1の熱処理後の分光透過率、ガラス面側分光 反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図4】例2の分光透過率、ガラス面側分光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図5】例2の熱処理後の分光透過率、ガラス面側分光 反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図6】例3の分光透過率、ガラス面側分光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図7】例3の熱処理後の分光透過率、ガラス面側分光 反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図8】例4の分光透過率、ガラス面側分光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図9】例4の熱処理後の分光透過率、ガラス面側分光 反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図10】例5の分光透過率、ガラス面側分光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図11】例5の熱処理後の分光透過率、ガラス面側分 光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図12】例6の分光透過率、ガラス面側分光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図13】例6の熱処理後の分光透過率、ガラス面側分 10 光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【図14】例7の分光透過率、ガラス面側分光反射率および膜面分光反射率を示す図。

【符号の説明】

10:基板

20

11:第1の光吸収膜

12:高屈折率膜

13:第2の光吸収膜

14:低屈折率膜

15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 3

9、42、45、48、51:分光透過率

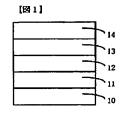
 $1\ 6\ ,\ 1\ 9\ ,\ 2\ 2\ ,\ 2\ 5\ ,\ 2\ 8\ ,\ 3\ 1\ ,\ 3\ 4\ ,\ 3\ 7\ ,\ 4$

0、43、46、49、52:ガラス面側分光反射率

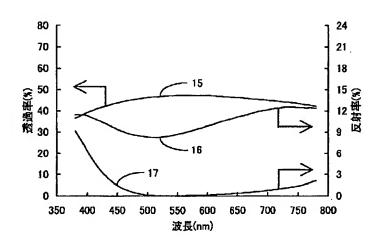
17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 4

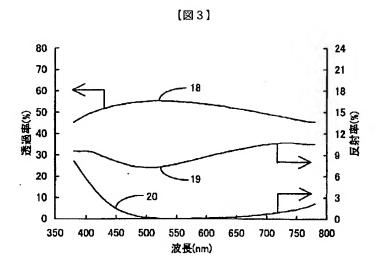
1、44、47、50、53:膜面分光反射率

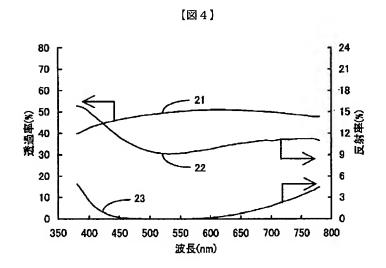
[図1]

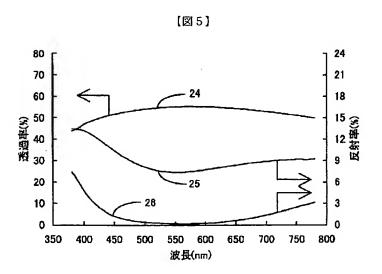


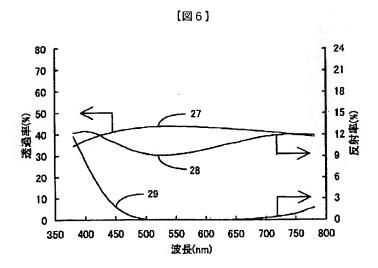
[図2]

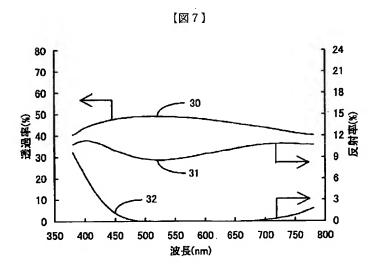


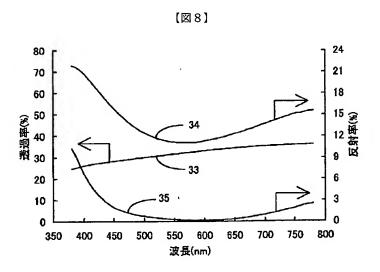


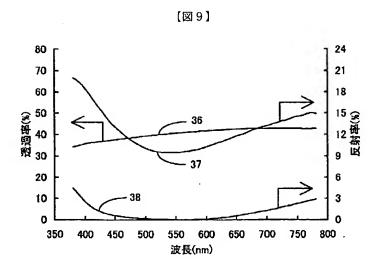


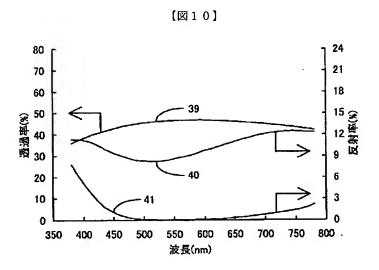


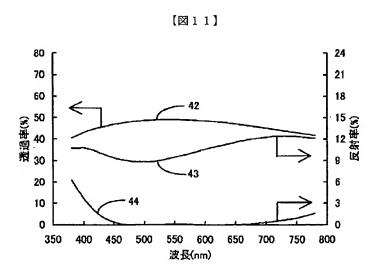




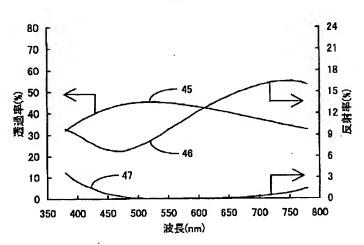




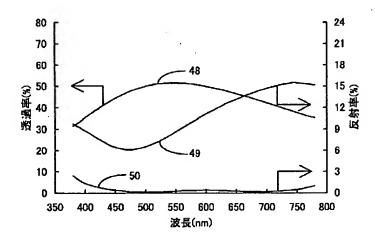




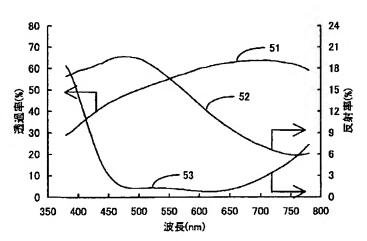
[図12]



[図13]



[図14]



フロントページの続き

Fターム(参考) 2K009 AA05 BB02 CC02 CC03 CC06 CC14 DD04

4F100 AA05E AA12C AA12D AA12E

AA13C AA16E AA17C AA20E

AA21C AA22C AA25C AA27C

AA28C AB01B AB01D AB10B

AB10D AB11B AB11D AB12B

AB12D AB19B AB19D AB31B

AB31D AD04C AD04D AD05

AD05E AD08E AG00A AT00A

BA05 BA07 BA10A BA10E

BA13 BA26 EH66 GB41 JA20B

JA20C JA20D JA20E JD08

JD08B JD08D JD14B JD14D

JG04 JJ03 JN06 JN06A

JN06E JN08 JN18C JN18E

JN30B JN30D YY00 YY00A

YY00B YY00C YY00D YY00E

5C032 AA02 DD02 DE01 DE03 DF05

DG01 DG02 DG04